



中華民國專利公報 [19] [12]

[11]公告編號：502377

[44]中華民國 91 年 (2002) 09 月 11 日

發明

全 6 頁

[51] Int.Cl.<sup>07</sup> : H01L21/76

[54]名稱：與聚合材料之粘著力增強之半導體裝置保護外層及其製法

[21]申請案號：090115185

[22]申請日期：中華民國 90 年 (2001) 06 月 22 日

[30]優先權：[31]60/213,300

[32]2000/06/22

[33]美國

[72]發明人：

史萊藍

美國

喬依莎

美國

[71]申請人：

德州儀器公司

美國

[74]代理人：蔡中曾 先生

1

2

[57]申請專利範圍：

- 1.一種具有增強粘著力的保護外層之積體電路，該外層包含下述薄膜層：  
第一層，由二氧化矽構成；  
第二層，由矽化合物構成，其係選自於由氮化矽、碳化矽、或氮氧化矽所組成之群組；以及  
第三層，包含二氧化矽之非常薄的薄層。
- 2.如申請專利範圍第1項所述之積體電路，其中該第一層之厚度係在 5,000 至 10,000 埃的範圍內。
- 3.如申請專利範圍第1項所述之積體電路，其中該第二層之厚度係在 1,000 至 5,000 埃的範圍內。
- 4.如申請專利範圍第1項所述之積體電路，其中該第三層之厚度係在 500 至 5,000 埃的範圍內。
- 5.如申請專利範圍第1項所述之積體電路，其中該等層係藉由電漿增強的化學氣相沈積法而沈積。

- 6.如申請專利範圍第1項所述之積體電路，其中該第三層具有與聚合材料之強大的粘著力。
- 7.如申請專利範圍第1項所述之積體電路，其中該外層係熱穩定至大於 450 °C。
- 8.如申請專利範圍第1項所述之積體電路，其中該保護外層係為對抗濕氣、機動離子與其他污染物進入之阻障。
- 9.如申請專利範圍第1項所述之積體電路，其中該第一與第三氧化層具有與該第二介電層之強大的粘著力。
- 10.一種保護薄膜，包含下述薄膜層：  
第一層，由二氧化矽構成；  
第二層，由矽化合物構成，其係選自於由氮化矽、氮氧化矽、或碳化矽所組成之群組。
- 11.一種具有與聚合材料之粘著力強之保護外層之覆晶半導體裝置，包含

- 下述層：  
 積體電路，具有第一表面，該第一表面擁有有源電路及互連；  
 保護外層，被沈積並圖案化在該第一表面上面，該外層包含二氧化矽層、包括選自於由氮化矽、碳化矽、或氮氧化矽所組成之群組之矽的第二介電層之化合物、以及二氧化矽之薄層；  
 底部填充聚合物；以及  
 基板，具有複數個焊球接點。
12. 如申請專利範圍第 11 項所述之半導體裝置，其中該裝置係為 BGA 封裝。
  13. 如申請專利範圍第 11 項所述之半導體裝置，其中該裝置係為 CSP。
  14. 一種具有與聚合材料之粘著力增強之保護外層之引線表面安裝型半導體裝置，包含：  
 積體電路，具有第一表面與第二表面，該第一表面擁有有源電路及互連，該第二表面裝設置導線架；  
 保護外層，被沈積並圖案化在該第一表面上面，該外層包含二氧化矽層、包括選自於由氮化矽、碳化矽、或氮氧化矽所組成之群組之矽化合物之第二介電層、以及第三層之二氧化矽；  
 複數條接合線，將晶片上之錫墊連接至導線架；以及模製化合物，包含環氧聚合物，用以封裝該具有增強粘著力的保護外層之積體電路晶片、該等接合線與該導線架之內部引線。
  15. 一種形成半導體裝置之方法，該半導體裝置具有保護外層，該保護外層與使用於封裝並在該外層之層間的聚合材料兩者之粘著力增強，該方法包含下述步驟：  
 將包含已製成積體電路之一個或更

- 多的半導體晶圓配置於電漿沈積反應器中；  
 在使用 PETEOS(電漿輔助四乙氧基矽烷)製程沈積二氧化矽層之前排空容室；  
 改變氣體供應以包含矽甲烷、氮與氨，使用 PECVD(電漿輔助化學氣相沈積)製程沈積氮化矽層；  
 改變氣體供應，使用 PETEOS 製程以沈積二氧化矽薄膜；以及  
 塗敷光阻，對錫墊及／或其他開口部進行光刻圖案化，並使用乾蝕刻製程以蝕刻保護外層中之開口部。
16. 一種形成半導體裝置之方法，該半導體裝置具有保護外層，該保護外層與使用於封裝並在該外層之層間的聚合材料兩者之粘著力增強，該方法包含下述步驟：  
 將具有已製成積體電路之一個或更多的半導體晶圓配置於電漿沈積反應器中；  
 在使用 PETEOS(電漿輔助四乙氧基矽烷)製程沈積二氧化矽層之前排空容室；  
 改變氣體供應以包含矽甲烷、氮、氧與氨，使用 PECVD(電漿輔助化學氣相沈積)製程沈積氮氧化矽層；  
 改變氣體供應，使用 PETEOS 製程以沈積二氧化矽薄膜；以及  
 塗敷光阻，對錫墊及／或其他開口部進行光刻圖案化，並使用乾蝕刻製程以蝕刻保護外層中之開口部。
  17. 一種形成半導體裝置之方法，該半導體裝置具有保護外層，該保護外層與使用於封裝並在該外層之層間的聚合材料兩者之粘著力增強，該方法包含下述步驟：  
 在使用 PETEOS(電漿輔助四乙氧基矽烷)製程沈積二氧化矽層之前排空容室；

(3)

5

改變氣體供應以包含矽甲烷／甲烷，或例如三甲基或四甲基矽甲烷之有機矽甲烷，使用PECVD(電漿輔助化學氣相沈積)製程沈積碳化矽層；  
改變氣體供應，使用PETEOS製程以沈積二氧化矽薄膜；以及  
塗敷光阻，對鋁墊及／或其他開口部進行光刻圖案化，並使用乾蝕刻製程以蝕刻保護外層中之開口部。

圖式簡單說明：

圖1係為具有底部填充封閉劑之晶片級封裝(習知技術)。

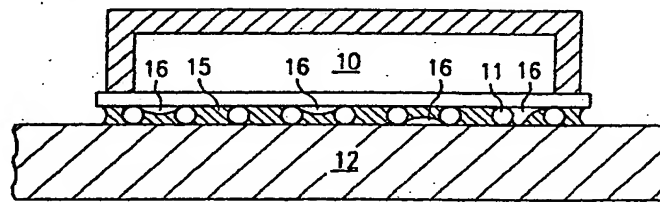


圖 1

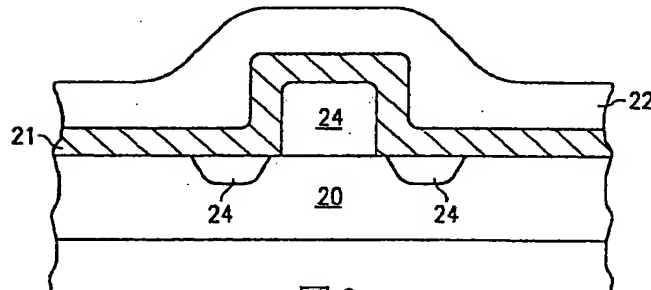


圖 2a

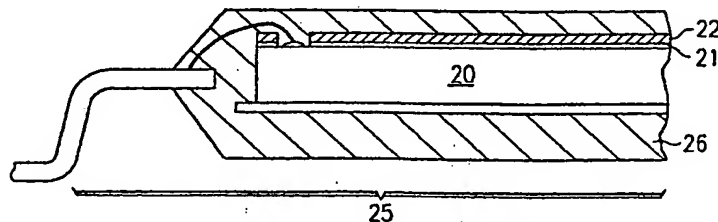


圖 2b

6

圖2a顯示具有覆蓋保護外層之聚醯亞胺粘著層之晶片表面(習知技術)。

圖2b係為以聚醯亞胺塗層包圍半導體裝置之引線塑膠封裝(習知技術)。

圖3顯示本發明之連續保護外層。

圖4a-4d顯示關於本發明之增強粘著力之保護外層之處理流程。

圖5係為在PO與底部填充材料之間具有增強粘著力之覆晶組合。

圖6係為本發明之模塑半導體裝置。

(4)

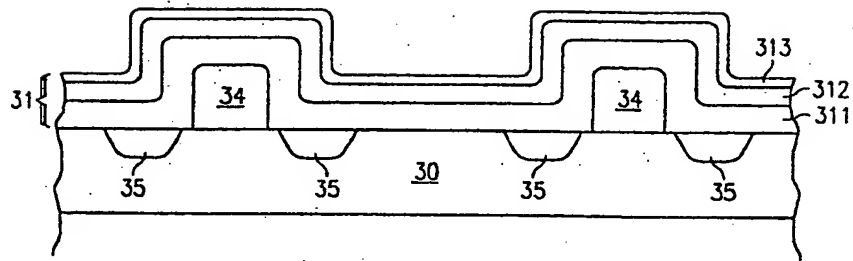


圖 3

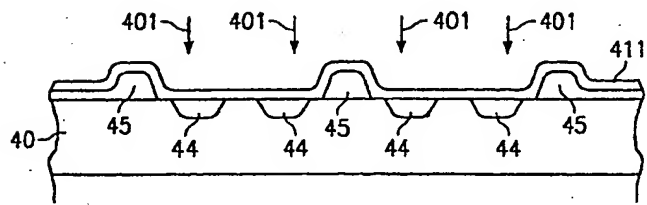


圖 4a

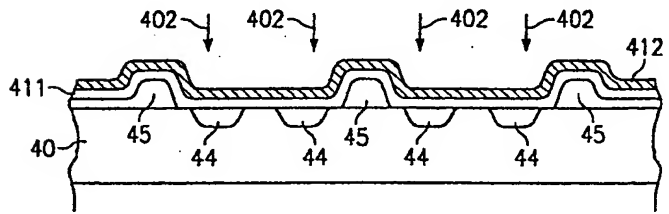


圖 4b

(5)

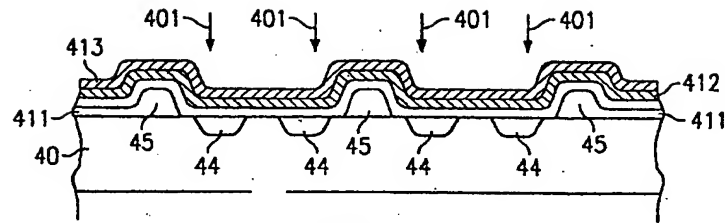


圖 4c

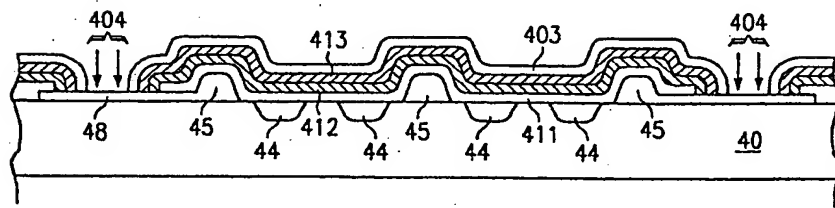


圖 4d

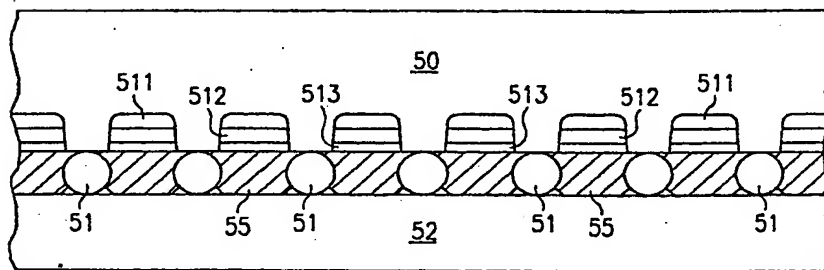


圖 5

(6)

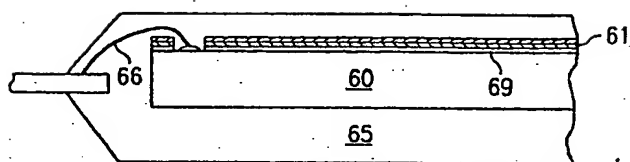


圖 6